



**Zentraler Artikelkatalog
der Volkswirtschaft der DDR**

ZAK-Nr.	TYP.	STANDARD MEK	PROD	LANDLIEF	BE-FUNKTION	BEM
13782.....	BEZEICHNUNG (TGL)					

Bipolare Transistoren (npn)

11 108 250020	SFE 250		10/90	DDR MSN	PNP-TRS.FT=2.3GHZ,SOT-23	35
11 108 292060	SFE 292		10/90	DDR MSN	PNP-TRS.FT=5GHZ,SOT-23	35
13 103 517477	SFE 517		10/90	DDR MSN	PNP-TRS.FT=1.2GHZ,SOT-89	35
12 100 519034	SSE 519		10/91	DDR MSN	PNP-TRS.160V,0.6A,SOT-89	38
12 100 540124	SSE 540		10/91	DDR MSN	PNP-TRS.60V,1A,B=40-120,SOT-8	38
12 100 541004	SSE 541		10/91	DDR MSN	PNP-TRS.60V,1A,B:100-300,SOT8	38
12 100 542007	SSE 542		10/91	DDR MSN	PNP-TRS.80V,1A,B:40-120,SOT-8	38
12 100 543106	SSE 543		10/91	DDR MSN	PNP-TRS.80V,1A,B=100-300,SOT8	38
14 106 305052	2 N 3055		77	UNG HWF	PNP-TRS.115W,60V,15A,TO-3	

Bipolare Transistoren (pnp)

34 107 160009	KD 616		78	CSSR HWF	PNP-TRS.70W,60V,10A,TO-3	15
34 107 170004	KD 617		78	CSSR HWF	PNP-TRS.70W,80V,10A,TO-3	15
31 109 033114	KT 203 A	TGL 35199	76	SU HWF	PNP-TRS.60V,10MA,UEB=30V	11
31 109 032007	KT 203 B	TGL 35199	76	SU HWF	PNP-TRS.30V,10MA,UEB=15V	11
31 109 203064	KT 203 W	TGL 35199	76	SU HWF	PNP-TRS.15V,10MA,UEB=10V	11
31 109 310070	KT 3109 A	TGL 42837	84	SU HWF	PNP-TRS.50MA,F=6.0DB/0.8GHZ	
31 109 310185	KT 3109 B	TGL 42837	84	SU HWF	PNP-TRS.50MA,F=7.0DB/0.8GHZ	
31 109 310281	KT 3109 W	TGL 42837	84	SU HWF	PNP-TRS.50MA,F=8.0DB/0.8GHZ	
31 109 312623	KT 3126 A	KME-S 085	84	SU HWF	PNP-TRS.20V,30MA,FT>0.5GHZ	
31 109 312631	KT 3126 B	KME-S 085	84	SU HWF	PNP-TRS.20V,30MA,FT>0.5GHZ	
31 109 312818	KT 3128 A		84	SU HWF	PNP-TRS.20V,20MA,FT>0.8GHZ	
31 109 130205	KT 313 A	TGL 38740	82	SU HWF	PNP-TRS.50V,0.35A,FT>200MAHZ	
31 109 130301	KT 313 B	TGL 38740	82	SU HWF	PNP-TRS.50V,0.35A,FT>200MAHZ	

Art.-Nr. 137 82 14 1	Typ	Art	Her- stel- ler	An- wen- der- stufe	Anwen- dung im Frequenz- bereich	Grenzwerte						Besonder- heiten Häufig- keit	Bau- form	Seite 137 82/
						f_{CBO}^* [V]	f_{CBO} [V]	f_c [A]	P_{tot} [W]	R_{th}^* [K/W]	R_{th}^* [K/W]			
30 010000	KD 501	nnp	ČSSR	NF	NF	40	5	20	150	0,866*	0,866*	TO-3		
30 020006	KD 502					60	5	20	150	0,866*	0,866*			
30 030001	KD 503					80	5	20	150	0,866*	0,866*			
49 550007	2 N 3055	nnp	UVR	NF	NF	100	7	15	117	1,5*	1,5*	TO-3		
30 050002	KD 605	nnp	ČSSR	NF	NF	40*	5	10	70	1,5*	1,5*	TO-3		
30 060008	KD 606					60*	5	10	70	1,5*	1,5*			
30 070003	KD 607					80*	5	10	70	1,5*	1,5*			
30 160009	KD 616					60*	5	10	70	1,5*	1,5*			
30 170004	KD 617					80*	5	10	70	1,5*	1,5*			
30 020006	KD 602	nnp	ČSSR	NF	NF	110	5	8	35	4,5*	4,5*	TO-3		
Art.-Nr. 137 82 12 1.,														
35 720002	KSY 72 K		ČSSR			40	4,5	0,2	700	200	200	TO-18		
43 690018	2 N 2369	nnp	UVR			40	4,5	0,2	360	480	480	TO-18		
43 790000	BF 479	pnp	UVR	HF	HF	30	3	0,05	0,16	600	600	TO-50		

Schlüssel-Nr. ELN: 137 82 14 1
Hersteller: UVR

ME: Stück (076)

Transistor 2N 3055

Si-npn-Leistungstransistor

Erzeugnisstandard: s. S. 137 82/1/47

Maßbild s. S. 137 82/0.7/36

Kennlinien s. S. 137 82/1.4/49...52

Preisbildung: PAO Nr. 382

Bilanzorgan:
Übergeordnetes Organ:
Entwicklungsstelle:
Importeur:
Lieferquelle:

HFO
KME
AHB EEI
HFO, AEB, MBH

Bezugseinschränkung
Garantie:

lt. vertraglicher Vereinbarung

Standards über
Einsatzbedingungen:
Internationale Standards
und Empfehlungen:
Grundlagenstandards:

ZAK-Nr. 137 82 14 106	Typ	Gleichstromverstärkung h_{21E}
305052	2N 3055	20—70 ¹⁾

¹⁾ bei $I_c = 4 \text{ A}$, $U_{CE} = 4 \text{ V}$

ZAK-Nummer: 137 82 14 106 305052

ZAK-Bezeichnung: TRANSISTOR 2N 3055

2N 3055

Technische Charakteristik

Verwendung:

Si-npn-Leistungstransistor für NF-Leistungsverstärker und Schaltanwendung

Masse: 15 g max.

Geometrische Abmessungen (Maßbild, Bauform): s. S. 137 82/0.7/36

Kennzeichnung: s. S. 137 82/0.7/32...34

Konstruktiver Aufbau:

Si-npn-Epibasis-Mesa-Transistor im Metallgehäuse
Kollektoranschluß am Gehäuse

Lieferform: unterschiedlich verpackt

Einbaulage: beliebig

Elektrische und thermische Kenngrößen**Grenzwerte** (gültig für den Temperaturbereich) $\vartheta_c = 25^\circ\text{C}$

		min.	max.	Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung bei $R_{BE} = 100 \Omega$, $I_C = 200 \text{ mA}$	U_{CER}		70	V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}		100	V
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}		60	V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}		7	V
Kollektor-Strom	I_C		15	A
Basisstrom	I_B		7	A
Gesamtverlustleistung	P_{tot}		117	W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j		200	$^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$

		min.	typ. ²⁾	max.	Einheit
Kollektor-Emitter-Reststrom bei $U_{CE} = 30 \text{ V}$, $I_B = 0$	I_{CEO}			0,7	mA
Emitter-Basis-Reststrom bei $U_{EB} = 7 \text{ V}$	I_{EBO}			5	mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei $I_C = 200 \text{ mA}$ ³⁾	$U_{(BR)CEO}$			60	V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei $U_{CEV} = 100 \text{ V}$, $-U_{BE} = 1,5 \text{ V}$ bei $U_{CEV} = 100 \text{ V}$, $-U_{BE} = 1,5 \text{ V}$ $\vartheta_a = 150^\circ\text{C}$	I_{CEV}			5 30	mA mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei $I_C = 200 \text{ mA}$, $R_{BE} = 100 \Omega$	$U_{(BR)CER}$			70	V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung bei $I_C = 4 \text{ A}$ ³⁾ , $I_B = 0,4 \text{ A}$ $I_C = 10 \text{ A}$, $I_B = 3,3 \text{ A}$	U_{CEsat}			1,1 8	V V
Basis-Emitter-Spannung bei $U_{CE} = 4 \text{ V}$, $I_C = 4 \text{ A}$	U_{BE}			1,8	V

2N 3055

		min.	typ. ²⁾	max.	Einheit
Gleichstromverstärkung bei $U_{CE} = 4 \text{ V}$, $I_C = 4 \text{ A}$	h_{21E}	20		70	
bei $U_{CE} = 4 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ A}$		5			

Dynamische Kennwerte

Transitfrequenz bei $U_{CE} = 4 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ A}$ $f = 1 \text{ MHz}$	f_T	800			kHz
--	-------	-----	--	--	-----

h-Parameter in Emitterschaltung
bei $U_{CE} = 4 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ A}$
 $f = 1 \text{ kHz}$

Kleinsignal-Kurzschluß- stromverstärkung	h_{21s}	15		120	
---	-----------	----	--	-----	--

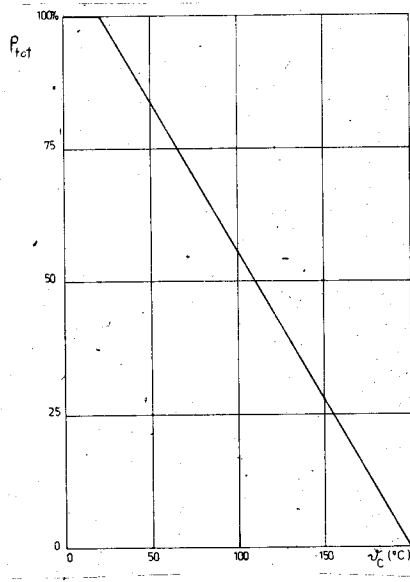
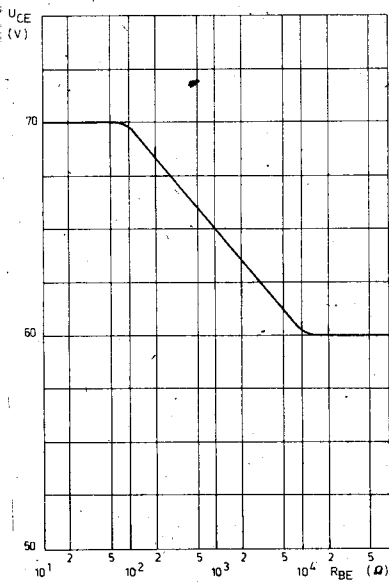
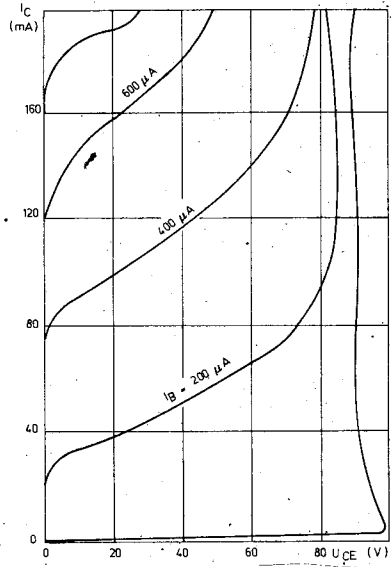
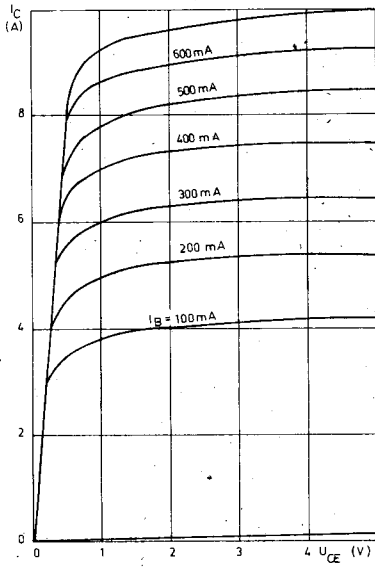
- 1) Anwendung der Meßverfahren nach TGL
- 2) Die angegebenen typischen Werte stellen Meßwerte dar, die chargenbedingt veränderlich sind.
- 3) Impulsmäßige Messung
- 4) siehe Meßschaltung für Schaltzeit

Thermische Kennwerte

Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	=	-40...125 °C
Wärmewiderstand	R_{thjc}	≤	1,5 K/W

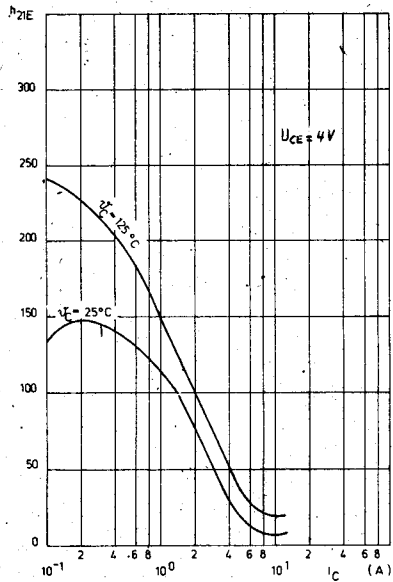
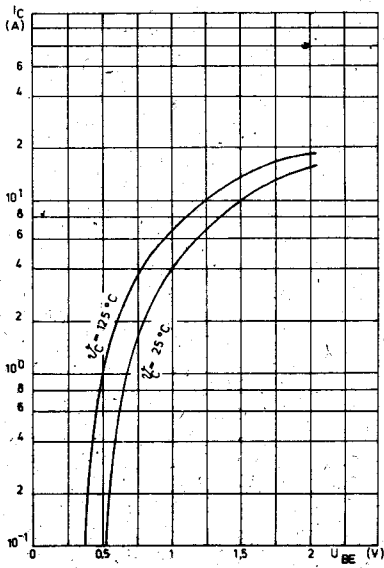
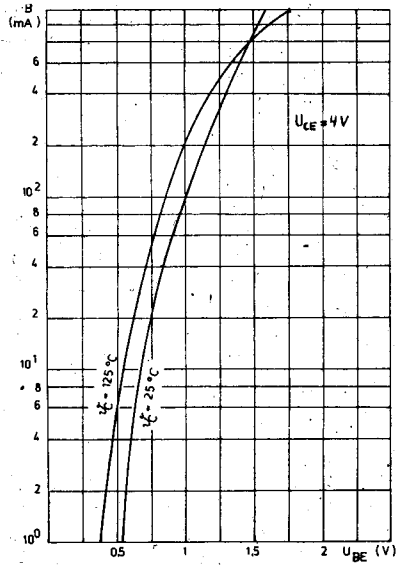
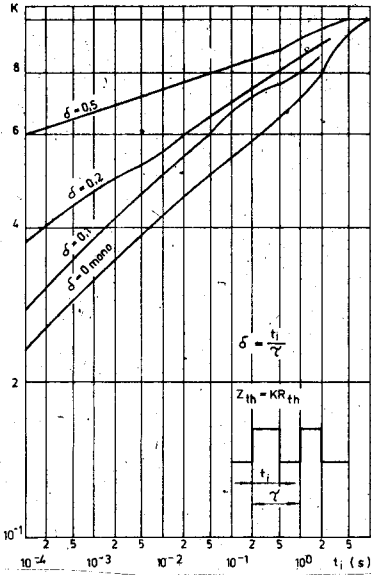
Kennlinien

2N 3055



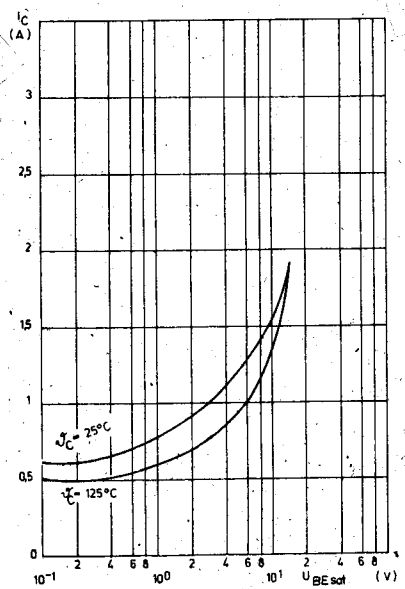
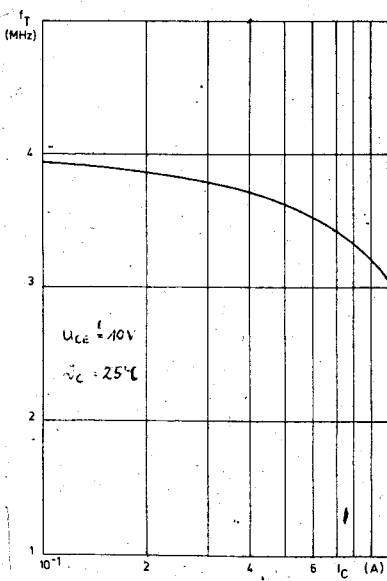
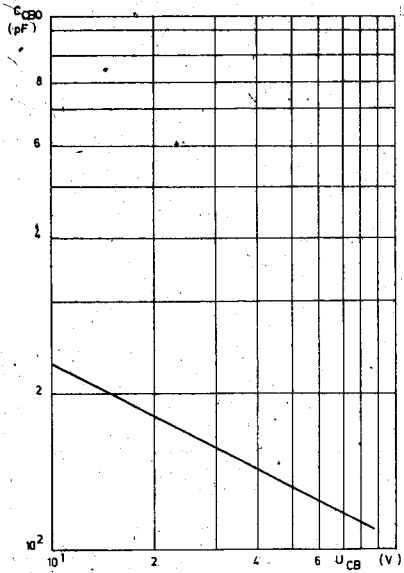
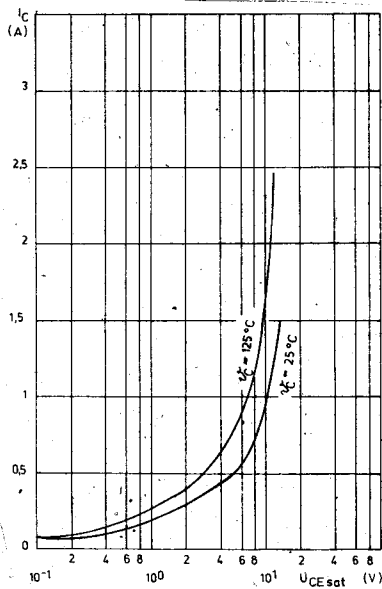
Kennlinien

2N 3055



Kennlinie

2N 3055



Kennlinien

2N 3055

Zulässige Impulsbelastbarkeit
 $I_c = f(U_{CE}), \theta_c = 25^\circ\text{C}$

